

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน

การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงผิวสัมผัส โดยการเคลือบด้วยฟิล์มบาง (Thin Films) เป็นการปรับปรุงผิวสัมผัสรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและกำลังได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถนำชิ้นงานที่ผ่านการปรับปรุงผิวสัมผัสแล้วไปใช้งานได้หลายด้าน เช่น การเคลือบแข็ง (Hard Coating) หรือ การเคลือบสวยงาม (Decorative Coating) หรือ การเคลือาแสง (Optical Coating) เป็นต้น ทั้งนี้การเคลือบผิวสัมผัสสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งแต่เดิมอุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการเคลือบด้วยไฟฟ้า (Electroplating) แต่วิธีนี้ใช้สารละลายนมกมีสารละลายเคมีที่ต้องทิ้งจำนวนมาก ซึ่งนอกจากยาการดำเนินการทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (สูรศิริ, 2540)

จากข้อจำกัดของการเคลือบด้วยไฟฟ้า ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาวิธีการเคลือบใหม่ ขึ้นมาทดแทน โดยการเคลือบวิธีใหม่ที่ได้รับความสนใจทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเดิม คือ การเคลือบในสูญญากาศ (Vacuum Coating) นี้องจากเรื่องการเคลือบที่เกิดในรีเวณสูญญากาศ ไม่ใช้สารละลายนมกมีสารละลายเคมีในกระบวนการเคลือบ และที่สำคัญฟิล์มบางหรือชั้นเคลือบที่ได้จากการเคลือบในสูญญากาศยังมีคุณภาพสูงมาก ทำให้การเคลือบในสูญญากาศได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จากทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียนที่ศึกษาในสูญญากาศ ยังแบ่งเป็นวิธีการต่าง ๆ ได้เป็นอีกหลายวิธี แต่ที่ได้รับความสนใจยิ่งมากในปัจจุบันคือ การเคลือบด้วยวิธีทางฟิสิกส์ หรือ การเคลือบด้วยไออกายภาพ (Physical Vapor Deposition; PVD) นี้องจากเป็นกระบวนการเคลือบที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการเกิดฟิล์มนิ่งได้ทั้งในด้านความหนาและคงทนมาก จึงสามารถเคลือบผิวสัมผัสได้หลากหลาย ทั้งโภภะ โลหะหรือของผสม (พิชัย, ลั่น สุวรรณ, 2551)

ทั้งนี้การเคลือบด้วยวิธีทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการไออกายภาพให้ความสนใจอย่างมากวิธีหนึ่ง คือ การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริ่ง (Sputtering) ซึ่งเป็นการเคลือบที่เกิดขึ้นภายในห้องเคลือบความดันต่ำ (ประมาณ 10^{-3} mbar) โดยอาศัยการดิสชาร์จไฟฟ้าให้เกิดสปัตเตอร์ตัวเป็นไอออน แล้วเร่งให้วิ่งเข้าชนแผ่นเป้าส เรากลีบ (Target) ซึ่งต่ออยู่กับขั้วลบของภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูง อนุภาคของเป้าสารเคลือบที่ถูกชนด้วยไอออนของเกลือสจะหลุดออกมาระหว่างวิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าชนและตกพื้น (Deposition) เป็นชั้นฟิล์มบางเคลือบนวัสดุรองรับ (Substrate) ในทุกทิศทาง (Bunshah, 1994)

หัวนี้ชั้นเคลือบแข็งที่ได้รับความสนใจคือ ธาตุกลุ่มทรานซิชันของสารประกอบในไตรด์ซึ่งเป็นสารประกอบของธาตุ 2 ชนิด ที่เรียกว่า Binary Nitride Coating หรือ Binary Nitride Hard Coating เช่น ไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) ซึ่งมีความเสถียรทั้งด้านเคมี ความร้อน และมีค่าความแข็งประมาณ 20 GPa (Chu, Shum, & Shen, 2006) มีสัมประสิทธิ์การเสียดทานต่ำ ด้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง และมีเสถียรภาพ (Chu et al., 2006) แต่มีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 550 °C ได้เนื่องจากฟิล์มเกิดออกซิเดชันทำให้ฟิล์มหลุดลอกและเสื่อมสภาพในที่สุด (Buranawong, Witit-Anun, Chaiyakun, Pokaiposit, & Limsuwan, 2011)

การแก้ปัญหาข้อจำกัดดังกล่าวของฟิล์มบางของสารประกอบของธาตุ 2 ชนิด ดังกล่าว แนวทางหนึ่ง คือการเติมอะตอมของธาตุบางชนิด เช่น Al, Cr, Zr เข้าไปในโครงสร้างของฟิล์ม เพื่อทำให้เป็นสารประกอบของธาตุ 3 ชนิดและเรียกฟิล์มนิโนดี้ว่า Ternary Nitride Coating หรือ Ternary Nitride Hard Coating ซึ่งเป็นฟิล์มบางที่มีสมบัติและประสิทธิภาพดีกว่าฟิล์มบางของสารประกอบของธาตุ 2 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความแข็งและความสามารถด้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง สำหรับฟิล์มบางแข็งของสารประกอบของธาตุ 3 ชนิดที่น่าสนใจคือ ไทเทเนียมอะลูминิเนียมไนไตรด์ (TiAlN) เนื่องจากเป็นฟิล์มบางหรือชั้นเคลือบแข็งที่มีความเสถียรทั้งทางด้านเคมีและความร้อน มีค่าความแข็งสูงมากประมาณ 35 GPa (Fanghua, Nan, Lun, & Geyang, 2005) ทนการขัดสีและการกัดกร่อนได้ดี ทั้งยังสามารถด้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงถึง 800 °C ทำให้สามารถใช้งานได้ดีกว่าไทเทเนียมไนไตรด์ (Kim, Lee, & Hahn, 2005)

สำหรับการเตรียมฟิล์มบางของสารประกอบของธาตุ 3 ชนิดของไทเทเนียมอะลูминิเนียมในไตรด์ ด้วยวิธีสาแปลดริง อาร์รัตน์ สมหวังสกุล (2556) ได้อธิบายว่าสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่ใช้ปืนสารเคลือบแบบอัลลอยด์ (Alloy Target) โดยการผสมไทเทเนียมและอะลูминิเนียมในอัตราส่วนที่ต้องการ แล้วขึ้นรูปเป็นปืนสารเคลือบ วิธีนี้จากใช้ปืนสารเคลือบชุดเดียว แต่มีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของสารเคลือบ เพราะต้องทำปืนสารเคลือบใหม่ทุกครั้งหากต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนของสารเคลือบ (2) กลุ่มที่ใช้ปืนสารเคลือบแบบโมเสก (Mosaic Target) โดยใช้อะลูминิเนียมคัดໄว้มีขนาดต่างๆ คัดฝังในเนื้อของไทเทเนียมที่เป็นสารเคลือบหลัก วิธีนี้ใช้ปืนสารเคลือบชุดเดียว แบรร์ค่าอัตราส่วนของสารเคลือบได้สะดวก แต่ยุ่งยากในการทำปืนสารเคลือบที่มีลักษณะเฉพาะ และ (3) กลุ่มที่ใช้ปืนสารเคลือบแบบร่วม (Co-Target) วิธีนี้เป็นการเคลือบโดยใช้ปืนสารเคลือบทองไทเทเนียมและอะลูминิเนียมในเนื้อฟิล์มที่เตรียมได้ตามที่ต้องการ โดยความคุณกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปืนสารเคลือบแต่ละชุด แต่เมื่อเลี้ยงเนื่องจากกระบวนการเคลือบที่จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงจำนวนมาก

ปกติโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มที่เคลือบได้มักขึ้นกับเทคนิคและเงื่อนไขการเคลือบ เป็นสำคัญ สำหรับฟิล์มบาง ไทเทเนียมอะลูминีียม ในไตรค์ มีนักวิจัยหลายกลุ่มให้ความสนใจศึกษา ผลของพารามิเตอร์การเคลือบฟิล์ม ได้แก่ อัตราไหลของแก๊สในไตรเจน หรือกำลังไฟฟ้าที่มีต่อ โครงสร้างของฟิล์ม เช่น Jeong, Hwang, and Lee (2002) ได้เตรียมฟิล์มบาง ไทเทเนียมอะลูминีียม ในไตรค์ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปั๊ดเตอริง เพื่อศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่อโครงสร้างฟิล์ม พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์รานบ (200) เป็น Preferred Orientation เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนลดลงพบว่าความเข้มรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์รานบ (200) มีค่าลดลง โดยฟิล์มนี้โครงสร้างแบบคลอลัมนาร์เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น หรือ Wuhrer and Yeung (2004) ได้เคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียมอะลูминีียม ในไตรค์ ด้วยวิธีรีแอคตีฟ แมกนีตรอน โคลสปั๊ดเตอริง เพื่อศึกษาผลของกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการกระบวนการเคลือบ โดยให้ ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้า (Power Density) ของปืนไทเทเนียมคงที่ เท่ากับ 0.9 W/cm^2 และ แปรค่าความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าของปืนอะลูминีียมในช่วง 1.5 ถึง 6.0 W/cm^2 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าของปืนอะลูминีียมเพิ่มขึ้น เกรนของฟิล์มนี้ค่าลดลงจาก 210 nm เป็น 90 nm ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนและกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปืนสารเคลือบ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของการเคลือบนั้น ส่วนมีผลสำคัญต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้ทึ้งสิ่น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาขั้นตอนการเตรียมสารประกอบในไตรค์ของธาตุสามชนิดใน ลักษณะฟิล์มบางของ ไทเทเนียมอะลูминีียม ในไตรค์ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปั๊ดเตอริง เพื่อศึกษาผล ของพารามิเตอร์การเคลือบ ได้แก่ อัตราไหลแก๊สของไนโตรเจน และกำลังไฟฟ้าของปืน ไทเทเนียม ที่มีต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่เคลือบได้ด้วยเทคนิค XRD, AFM, FE-SEM และ EDX เพื่อใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบาง ไทเทเนียมอะลูминีียม ในไตรค์ด้วยวิธีรีแอคตีฟ โคลสปั๊ดเตอริง
2. เพื่อศึกษาผลของพารามิเตอร์การเคลือบท่อโครงสร้างของฟิล์มบาง ไทเทเนียม อะลูминีียม ในไตรค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ทำให้ทราบขั้นตอนและกระบวนการเตรียมฟิล์มบางไกเทเนียมอะลูมิเนียมในไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟโคลสปีตเตอริง และทราบลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD, AFM FE-SEM และ EDX เพื่อนำมาสรุปหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเคลือบท่อสักหะเฉพาะของฟิล์มบางไกเทเนียมอะลูมิเนียมในไตรด์เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิจัยต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษา เทคนิคขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางไกเทเนียมอะลูมิเนียมในไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟโคลสปีตเตอริง โดยพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาคือ อัตราไอลแก๊สในไตรเจน และกำลังไฟฟ้าของไฟไกเทเนียม ในส่วนการวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม ใช้เทคนิค XRD เพื่อศึกษาเฟส โครงสร้างผลึก และขนาดผลึก ใช้เทคนิค AFM ศึกษาลักษณะพื้นผิวและความหนาใช้ FE-SEM ศึกษาโครงสร้างจุลภาค สุดท้ายใช้ EDX ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มที่เคลือบได้